

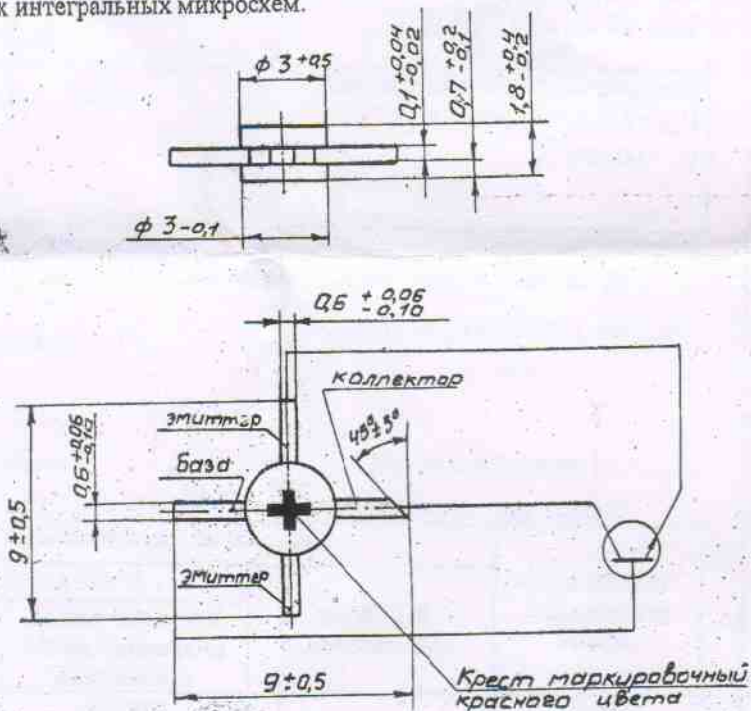


Транзистор 2Т657А-2

Дата изготовления 20 15.01
(год, месяц)

ЭТИКЕТКА

Кремниевый эпитаксиально-планарный бескорпусной п-р-п транзистор 2Т657А-2, предназначенный для применения в схеме с общим эмиттером усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот до 2 ГГц в составе гибридных интегральных микросхем.



Масса не более 0,2 г.

Основные электрические параметры при $t_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток кollectор-эмиттер, мА, $U_{кз} = 12 \text{ В}, R_{зб} = 1 \text{ кОм}$	$I_{кзР}$	-	1
Обратный ток эмиттера, мА, $U_{зб} = 2 \text{ В}$	$I_{збо}$	-	0,1
Выходная мощность, мВт, $U_{кв} = 7 \text{ В}, I_3 = 45 \text{ мА}, f = 2 \text{ ГГц},$ $\delta K_{ур} \leq 2 \text{ дБ}, t_{кр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$	$P_{вых}$	50	-
Коэффициент усиления по мощности, дБ, $U_{кв} = 7 \text{ В}, I_3 = 45 \text{ мА}, f = 2 \text{ ГГц},$ $t_{кр} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ Примечание	$K_{ур}$	8	-

Примечание – Значение $K_{ур}$ указано в пределах линейного участка амплитудной характеристики.

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. транзисторов, г	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода, г/мм	Толщина покрытия, мкм
золото		0,00009	5
серебро		-	-

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзистор 2Т657А-2 соответствует техническим условиям аАО.339.405 ТУ.

Принят по извещению № 1 от 2015.01 дата

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
военного представительства

Место для штампа «Перепроверка произведена _____» дата

Принят по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
военного представительства